				平成26年	達 沼津	工業高等専門学校シラバス		
5年	科目	パワーエレクトロニク ス	講義	後期	担当	江間 敏		
電気電子工学科		Power-electronics	選択	1履修単位	坦크	EMA Satoshi		
授業の概要								
電力用ダイオード、サ	イリスタ、	GTO、IGBTなどのパ	ワーデバイ	イスが目ざましい進步	を遂げ、『	電力の変換、制御を応用した		

電力用ダイオード、サイリスタ、GTO、IGBTなどのパワーデバイスが目ざましい進歩を遂げ、電力の変換、制御を応用した「パワーエレクトロニクス」の分野は格段に広がっている。エアコン、蛍光灯からソーラー発電、ロボットそして新幹線などである。半期の本講義においては、主に6種類のパワーデバイスと整流回路とインバータの基本的回路について、図表や演習問題を多数用いながら講義を進め、着実な理解をはかる。

	$\setminus$	目標	説明
		1	技術者の社会的役割と責任を自覚する態度
本校学習・教育目標(本科の	0	2	自然科学の成果を社会の要請に応えて応用する能力
み)		3	工学技術の専門的知識を創造的に活用する能力
		4	豊かな国際感覚とコミュニケーション能力
		5	実践的技術者として計画的に自己研鑽を継続する姿勢
プログラム学習・教育目標 (プログラム対象科目のみ)	B. 数学、自然科学及び情報技術を応用し、活用する能力を備え、社会の要求にこたえる姿勢		
実践指針 (専攻科のみ)			

## 授業目標

前半のデバイスでは、半導体の基礎特性と6種類のデバイスの基礎的特性を理解すること。後半の整流回路では単相及び三相全波整流回路を理解すること。インバータ回路では、原理を理解し、ブリッジ形、PWM回路まで理解すること。

		拉来引压				
	_					
第1回		パワーエレクトロニクスとは(パワーデバイス、電力制御、インバータ制御など)				
第2回	パワー半導体	半導体の基礎特性と電力用ダイオード				
第3回	パワーデバイス	パワートランジスタ				
第4回		パワーMOSFET				
第5回		IGBT				
第6回		サイリスタの基礎特性とGTO				
第7回		パワーエレクトロニクスの周辺技術(IPM、冷却方式など)				
第8回		到達度チェック(中間試験)				
第9回	整流回路	単相整流回路の基礎				
第10回		単相全波整流回路				
第11回		三相整流回路				
第12回	インバータ	インバータ回路の原理				
第13回		種々のインバータ回路(ブリッジ形、PWM など)				
第14回	<del></del>	インバータと高調波障害				
** <u> </u>	前期末試験					
第15回		試験解説・授業アンケート				
第16回						
第17回						
第18回						
第19回 第20回						
第21回						
第22回						
第23回						
第24回						
第25回						
第26回						
第27回						
第28回						
第29回						
第30回						
評価方法 と基準		)平均成績を70%、課題レポート10%、授業への積極姿勢(出席状況、受講態度 て評価を行う。60点以上を合格とする。				
教科書等	・教科書:「パワーエレクトロニクス」 江間敏・高橋勲 コロナ社 ・参考書: プリントを適宜使う					
備考		等は、JABEE、大学評価・学位授与機構、文部科学省の教育実施検査に使用することがあります。				
	2.授業参観される教員は当該授業が行われる少なくとも1週間前に教科目担当教員へ連絡してください					